資料番号 160-5

スパッタ法による感温磁性薄膜の作製と特性評価

Preparation and Characterization of Temperature-Sensitive Magnetic Thin Film by Sputtering Method

○石井 修,安宍善史,島津誠-,長田 洋,千葉茂樹,菊池 孝,関享士郎
○Osamu Ishii, Yoshifumi Ajishi, Seiichi Shimazu, Hiroshi Osada,
Shigeki Chiba, Takashi Kikuchi, Kyoshiro Seki

岩手大学

Iwate University

関享士郎, Tel.0196(21)6380 Fax.0196(21)6380, E-mail:seki@msv.cc.iwate-u.ac.jp

1 緒言

一般に、電気機器に使用される磁性材料 は、機器の発熱や周囲の温度変化などによ る磁気特性の変動の小さいことが要求され る.しかし、使用温度範囲で磁性材料の特 性を急変させて、計測、制御、情報、エネ ルギー変換などの分野に利用する研究も進 められてきている.

本研究では、温度依存性をもつ、感温磁 性薄膜(Temperature-Sensitive Magnetic Thin Film:以下 TMF と略す)の作製と感 温アモルファス膜を用いた光センサの構成 について検討を行った。

2 感温磁性薄膜 TMF^{1,2)}

感温磁性薄膜 TMF は、スパッタリング と熱処理の行程を経て作製される. Mn-Zn 系フェライトをターゲットとした RF スパ ッタにより、Si 基板上に Mn, Zn, Fe の複 合金属膜を形成させ、熱処理により磁気構 造の結晶体に成長させる.

TMF の磁気的性質を左右するパラメー タは、ターゲットに用いる Mn-Zn 系フェラ イトの成分比、スパッタ時における RF パ ワーやスパッタ時間、雰囲気および雰囲気 圧、熱処理時における温度、時間、熱処理 雰囲気などが挙げられる、このため本研究 では、主に熱処理時間をパラメータとして

1

キーワード: 感温磁性膜 (temperature-sensitive film), スパッタ法 (sputtering method), マイクロセンサ (micro sensor)

連絡先:〒020 岩手県盛岡市上田 4·3·5 岩手大学工学部電気電子工学科 電子システム工学講座

変化させ、TMFの磁気的性質を測定した.

2.1TMF の作製行程

Fig. 1 に TMF の作製工程を示す. キュ リー温度 Tc=30 (℃)の Mn-Zn 系フェラ イトをターゲットとして, RF スパッタリン グによりスパッタ薄膜を作製する. 次にス パッタ薄膜に熱処理を施すと TMF が作製 される.

本研究では TMF の熱入力に対するセン サとしての活用を指標にするため、TMF の キュリー温度を室温付近にすることを目標 にした. このため、ターゲットと TMF の 特性が同一になるものと仮定して、ターゲ ットにキュリー温度 Tc=30 (°C) の Mn-Zn バルクフェライトを用いて薄膜の作製を行 う.

2.2 熱処理

スパッタで化合物ターゲットを用いる場 合,純ガス雰囲気中でスパッタを行うと, 膜組成はターゲットと比較してガス成分元 素が欠乏しやすい.本研究では、スパッタ 膜が酸素不足であることが予想される.ま た、薄膜の形成時にはスパッタ粒子は高温 気相から基板上の室温固相へと急冷される ことになる.これにより、スパッタ薄膜は 非晶質である可能性が高い.

これらを考慮し、熱処理工程では熱処理



Fig. 1 Preparation profile of TMF

雰囲気を酸素として炉内に 100ml/min の 割合で流し, 薄膜中の金属原子と酸素原子 を再結合させ, また, 完全固化したスパッ 夕薄膜に熱エネルギーを加えることにより 再結晶化させる.

バルクフェライトの固相反応は 800~ 1050℃の間で生じるため、スパック膜の熱 処理温度は 1000℃とする.また、 実際の バルクフェライトは仮焼成を 1~4 時間行 い、固相反応を進めている.これにさらに 本焼成の工程があるので、全体として 2~7 時間程度の焼成により Mn、Fe, Zn の 3 元 系からフェライト成分の生成を行っている と考えられる.これを考慮して本研究での スパッタ薄膜の熱処理時間は 1~8 時間と する.

3TMF の特性評価

TMF の特性評価は,表面観察に走査型電 子顕微鏡(SEM),組成分析にエネルギー 分散型 X 線分光法(EDX),構造分析に X 線回折装置,磁気特性の測定に振動試料型 磁力計(VSM)を用いた.

Fig. 2(a) は熱処理前の TMF の SEM 像である. 同図より表面は非常に平滑であ ることがわかる. Fig. 2(b) は熱処理を 4 時間行った TMF の SEM 像である. 無数の 微細なクラックがみられる.



 $20 \ \mu$ m

(a) no annealing (b) annealing for 4hours Fig. 2 SEM images of TMF Fig. 3は熱処理を4時間行ったTMFのX 線回折図である.同図より熱処理行程にて TMF はスピネル構造をとるようになるこ とがわかる.

Fig. 4 (a) は熱処理前の TMF の M-H 曲 線である. ほとんど磁化をもっていないこ とがわかる. Fig. 4 (b) は熱処理を 4 時間 行った TMF の M-H 曲線である. これによ り熱処理行程にて TMF に磁化が与えられ ることがわかる. 磁界 H が 500 (Oe) のと きの磁化 M の値を Ms として, 熱処理時間 による Ms の変化を示したものが Fig. 5 で ある. 今回作成した試料では, 熱処理時間 7 時間の TMF の Ms が最が大きい.

温度依存性に着目した場合, Fig. 4(a) より, 熱処理前の TMF はほとんど温度依 存性を持たないことがわかる. Fig. 4(b) は熱処理を4時間行った TMF の M-H 曲線 であるが, これにより熱処理行程にて温度 依存性が与えられることがわかる. 試料温 度が 10[°]Cのときの M_sの値を1として試料 温度の上昇に伴う M_sの変化の割合を示し たのが Fig. 6 である. 熱処理時間が長くな るに伴い温度依存性が強まるなどといった 傾向は確認できない.







Fig. 5 The variation in Ms as a function of the annealing time

2 4 6 Anneal Time(hour)

0

n



Fig. 6 The variation in rate of change in Ms as a function of the sample temperature 4 感温磁性膜を用いた光センサ³⁾

AMPS (Amorphous Magnetic Photo Sensor)は光エネルギーを吸収して磁気特 性が変化する光磁気変換素子である.従来 の受光素子には、光導電効果、光起電力効 果、光電子放射効果および焦電効果などを 利用したものがありそれぞれ実用されてい る、これらはいずれも受光部の電気的特性 が光によって変化する性質を利用したもの である. これに対し、AMPS はその磁気特 性であるレラクタンスの温度依存性を利用 した変換素子である. AMPS は感温アモル ファス磁性膜の表面に放射吸収物質を塗布 したもので、広い範囲におよぶ波長の光エ ネルギーを吸収する. その結果, 素子温度 が上昇し磁気特性であるレラクタンスが増 大する.この変化をホール素子読み出し法 により、光を電圧に変換することができる. 4.1 光センサの構成

TMF の応用例の一つとして、光センサを 示す. Fig.7 は AMPS の概略である. AMPS はアモルファス磁性膜 AF(Amorphous magnetic Film)にバインダを添付して、プ ラスチック基板 S に固着させた厚膜で、サ





イズは 4mm×15mm の長方形である. 磁 性膜は厚さが 20 µ m のフレーク状となっ ており、バインダとしてエポキシ樹脂を用 いた. 磁性膜の表面に放射吸収物質 RA を 塗布すると AMPS が作製される. AF の組 成は主成分が Fe-P-Cr 系アモルファスであ る. 従来,熱型電気式検出器の受光面に塗 布または付着させて吸収率を高くするため に、金、亜鉛、白金などの金属黒やカーボ ンブラックなどの放射吸収物質がある. こ れらはいずれも高い吸収率と熱伝導率を有 している. ここでは、白金黒とカーボンブ ラックを用いた.

光を照射して変化する AMPS の磁気特 性を検出するために、Fig. 8 に示すホール 素子法を考案した.装置は、基板 S、ホー ル素子 H、U字形磁心 M、巻線 N、ケース Cにより構成される.Mを巻線 Nを介して 一定交流電圧で励磁すると、Mの磁極から 磁束Φが発生し、M-H-S-PS-S-M なる磁気 回路を形成するため、H よりホール素子の 出力電圧 V_Hが発生する.光Lが AMPS に 照射されると AMPS がそのエネルギーを 吸収して素子温度を上昇させるのでレラク タンスが増大する.磁気回路中では磁束が 一定であるため、AMPS のレラクタンスの 増加により磁束Φが減少し,その結果 V_H も減少する.この変化を次段の信号処理回 路 SP に導く.光信号読み出しには,磁気 ヘッドによる方法も考えられるが,この方 法は磁気ヘッドを AMPS の上部に設置す るため,光の入射が妨げられる恐れがある. ホール素子法は入射角度に関係なく光を照 射できること,読み出し部を AMPS の下部 ばかりではなく左右に設置することができ る.

5 結言

このようにスパッタ法を用い,熱処理を 加えることにより温度依存性を持つ磁性薄 膜が得られた.しかし TMF を光センサへ 応用する場合,温度依存性や透磁率の面で 問題が残るが作製時のパラメータ,特に熱 処理行程にて改善が可能であるものと考え る.

以上, 感温磁性薄膜の作製と感温磁性膜 を用いた光センサの構成について検討を行 った.

文献

1) 長田 洋, 安宍 善史, 菊池 孝, 田山 典 男, 関 享士郎, 菊地 新喜: 感温磁性薄膜 センサの作製と基礎特性, 日本応用磁気学会 誌, Vol.20, No.2, 565/568 (1996)

2) Hiroshi Osada, Kyoshiro Seki, Hidetoshi Matsuki, Shinki Kikuchi, Koichi Murakami: Temperature-Sensitive Magnetic Thin-Film for Micro Sensor, IEEE Trans. Magn., Vol. 31, No. 6, 3164/3166, November 1995

3)長田洋,安宍善史,関 享士郎,松
木 英敏,菊地 新喜:アモルファス磁性体
受光素子の構成と基礎特性,計測自動制御学
会論文集, Vol.32, No.2, 151/155 (1996)



Fig. 8 Schematic of light-magnetic conversion on AMPS